# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-222764

(43) Date of publication of application: 11.08.2000

(51)Int.CI.

G11B 7/135 G01N 13/14 G01N 13/10 7/24 G11B

(21)Application number: 11-023968

(71)Applicant: AGENCY OF IND SCIENCE & TECHNOL

MINOLTA CO LTD

(22)Date of filing:

01.02.1999

(72)Inventor: TOMINAGA JUNJI

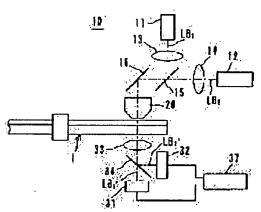
ATODA NOBUFUMI

SATO AKIRA

## (54) OPTICAL READER, OPTICAL READING METHOD AND OPTICAL RECORDING MEDIUM (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical reader having a good reading signal S/N ratio in a high density optical memory using a proximate field light, an optical reading method and an optical recording medium.

SOLUTION: This optical reader is provided with a probe 20 for generating a proximate field light, light sources 11 and 12 for emitting the light beams LB1 and LB2 of different wavelengths, optical elements 15 and 16 for guiding the light beams to the probe 20, photodetectors 31 and 32 detecting light beams LB1' and LB2' effused out of the probe 20 and transmitted through an optical recording medium 1, and a detecting circuit 37. The recording layer of the optical recording medium 1 has a recording pit formed to have larger transmittance with respect to the light beams LB1 and LB2, and a difference in detected values between the detectors 31 and 32 is set as a reading signal.



### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

1011137000-227754-(12000-227

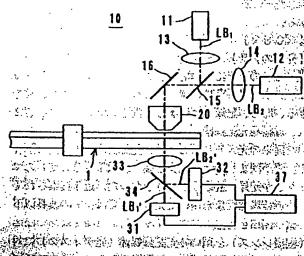
(19)日本国特群庁 (JP) (12) 公開特	許公報(A) (II)特許出願公開番月、湯。源
	SALEBOOOD COORDA
。 上述此所能。 1855年1878年1878年1878年1878年	(P2000-222764A)
A CONTRACT OF THE PROPERTY OF	(43)公開日 平成12年8月11日(2000, 8, 11)
(51)Int.CLL 经现金的证据的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的	the second secon
G 1 1 B 7/135 (	
G0 1 N 13/14	
13/10	
C11 P 27/24 27 19 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	messe mense, veres the second
GIID (1/24 -) 1 2 4 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	第 G11B 7/24 名 5 - 522A
2、本金里以来65.00年以及政策。《全线中国共和国	
一多。在1955年中國共產黨的學生學。在1955年	
(21) 山岡平島	
(21)出願番号 系统 特願平11 = 23968 度常的 2000 1000	27.00
(ON HISSE	
(22)出願日 平成11年2月1日(1999.2.1)	
	(74)上記1名の復代理人 100091432 (音楽) (音楽)
The state of the s	<b>弁理士 森下 武一 (外1名)</b> ************************************
	(71)出顧人 000006079
••	ミノルタ株式会社 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号
	大阪国際ビル
$\mathbb{R}^{2} \times \mathbb{R}^{2} = \mathbb{R}^{2} \times \mathbb{R}^{2} \times \mathbb{R}^{2}$ .	(74)上記1名の代理人 100091432
State of the state of the state of	弁理士 森下 武一
the second second	
	・最終頁に続く

### (54) 【発明の名称】 . 光読取り装置、光読取り方法及び光記録媒体

#### (57)【要約】。

【課題】 近接場光を利用した高密度光メモリにおいて、読取り信号のS/N比の良好な光読取り装置、光読取り方法及び光記録媒体を得る。

【解決手段】 近接場光を発生するプローブ20と、異なる波長の光ビームLB1、LB2を放射する光源11,12と、光ビームをプローブ20へ導く光学素子15,16と、プローブ20から浸み出して光記録媒体1を透過した光ビームLB1、LB2で検出する光検出器31,32と、検出回路37とからなる光読取り装置。光記録媒体1の記録層は光ビームLB1、LB2に対して透過率が大きく異なる記録ビットが形成されており、検出器31、32による検出値の差分を読取り信号とする。 場合の表現を記録というが形成されており、検出器31、32による検出値の差分を読取り信号とする。 場合の表現を記録というには、対して表現に対して表現に対して表現によりによる検出値の差分を読取り信号とする。 場合の表現を記録を表現に対して表現に対して表現によりに表現によりに表現によりに表現による。



TOTAL TENENT TO THE TOTAL TOTAL

(2) 000-222764 (P2000-222764A)

【特許請求の範囲】劉起義等(11)

【請求項1】 近接場光発生素子と、

互いに波長の異なる第1の光ビーム及び第2の光ビーム を放射する第1及び第2の光源と、開発(音)

前記第1及び第2の光ビームを前記近接場光発生素子に 入射させる光学手段と、

前記近接場光発生素子から浸み出して光記録媒体を透過 又は光記録媒体で反射した第1及び第2の光ビームを検 出する第1及び第2の光検出器と

前記第1及び第2の検出器による検出値の差分を読取り 10 信号とする検出手段と、でき

を備えたことを特徴とする光読取り装置。キーの金融の

【請求項2】 前記近接場光発生素子は微小開口又は微一 小光透過部を有するプローブであることを特徴とする請 求項1記載の光読取り装置。 三三年芸堂工

【請求項3】 互いに波長の異なる第1及び第2の光ビ ームを近接場光発生素子に入射させ、浄学の含までは、

前記近接場光発生素子から浸み出して光記録媒体を透過 又は光記録媒体で反射した第1及び第2の光ビームを検 出し、該検出値の差分を読取り信号とすること、 を特徴とする光読取り方法。

【請求項4】 金属からなる膜と光吸収性の大きな材料 からなる膜との多層記録層を備えた光記録媒体であっ て、前記多層記録層上に光ビームを集光させることによ って近接場光を発生させる微小光透過部を形成する薄膜 を備えたことを特徴とする光記録媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、近接場光現象を利 用した光読取り装置、光読取り方法及び光記録媒体に関 30 する.

[0002]

【発明の背景】近年、光学的に情報を記録/読取りする 光メモリの分野においては、コンピュータの高速化やマ ルチメディアの発達に伴い、より大容量の情報を記録で きる、即ち、記録密度の著しく向上した光ヘッドが望ま れ、近接場光記録技術が提案されている。レーザ光を用 いた従来の光メモリにおいて、記録密度は光の回折限界 で上限が決まり、光の波長程度(約数100nm)のマ ークしか記録/読取りができなかった。近年提案されて いる近接場光現象を用いた光メモリでは、光の波長以下 の微小開口を有するプローブやSolid Immersion Lens (固浸レンズ)を用いて光記録媒体(光ディスク)に対 して光ヘッドと記録媒体との間隔を数10 nmまで近づ けた状態で記録/読取り用の光を照射することで、光の 回折限界を超えて数10mmという小さなマークを信号。 として書き込み、読み取ることが可能である。 [0003]

【発明が解決しようとする課題】ところできこのような 近接場光記録技術においては、従来の光記録技術に比べ。50 10010 さらに、本発明に係る光記録媒体は、前記

て読取りが光ヘッドと光記録媒体とのギャップ誤差やト ラッキング誤差に非常に敏感になり、これらの微小な誤 差によって検出信号の強度が大きく変動し、読取り信号。 のS/N比が悪化するという問題点を有していた。

【0004】そこで、本発明の目的は、読取り信号のS /N比の良好な光読取り装置、光読取り方法及びこれら の装置及び方法に使用される光記録媒体を提供すること にある. [0005]

【発明の構成、作用及び効果】以上の目的を達成するた め、本発明に係る光読取り装置は、近接場光発生紫子 と、互いに波長の異なる第1の光ビーム及び第2の光ビ ームを放射する第1及び第2の光源と、第1及び第2の 光ビームを近接場光発生衆子に入射させる光学手段と、 近接場光発生素子から浸み出して光記録媒体を透過又は 光記録媒体で反射した第1及び第2の光ビームを検出す る第1及び第2の光検出器と、この第1及び第2の検出 器による検出値の差分を読取り信号とする検出手段とを 備えている。

【0006】また、本発明に係る光読取り方法は、互い に波長の異なる第1及び第2の光ビームを近接場光発生 **索子に入射させ、この素子から浸み出して光記録媒体を** 透過又は光記録媒体で反射した第1及び第2の光ビーム を検出し、該検出値の差分を読取り信号とする。

【0007】以上の本発明において、光記録媒体の記録 層としては、情報が記録されるピットが、波長の異なる 第1光ビーム及び第2光ビームに対してそれぞれ特定の 透過率又は反射率を有しているものを使用する。この記 録層を透過又は反射する第1及び第2の光ビームを検出 すると、記録ピットの部分で検出値に大きな差分が得ら れる。この差分はトラッキング誤差等で第1及び第2の 光ビームの検出信号自体の強度が変動しても一定の値を 保持する。本発明においては、この差分を読取り信号と するため、検出信号自体の揺らぎに拘らず、S/N比の 高い良好な読取り信号を得ることができる。

【0008】さらに、本発明において、近接場光発生素 子として微小開口又は微小光透過部を有するプローブを 使用してもよい。このようなプローブを使用すれば、第 1及び第2の光ビームの光軸を厳密に合わせる必要がな く、装置の組立てが容易になる。

【0009】また、本発明に係る光記録媒体は、金属か らなる膜と光吸収性の大きな材料からなる膜との多層記。 録層を備えている。この種の多層記録層は、光ビームを 照射することで、光吸収材に吸収された熱で金属と光吸 収材とが相互拡散して記録ピットが形成される。この記述 録ピットは異なる波長の光に対する透過率又は反射率が影響 異なる特性を有する。従って、この光記録媒体を使用す ることによって前記光読取り装置及び光読取り方法にて 好適に情報を読み取ることができる。

3

多層記録層上に光ビームを集光させることによって近接場光を発生させる微小光透過部を形成する薄膜を備えていてもよい。この薄膜は光ビームを集光することで溶融して微小光透過部が形成され、この微小光透過部が近接場光を発生するプローブとして機能する。そして、ここで発生した近接場光が前記多層記録層を照射し、記録ビットを形成することになる。

【発明の実施の形態】以下、本発明に係る光読取り装置。 光読取り方法及び光記録媒体の実施形態について、第 10

添付図面を参照して説明する。

【0012】図1は、第1実施形態としての光読取り装置10を示し、概略、レーザ光源11,12とプローブ20と、光検出器31,32と、検出回路37とで構成されている。レーザ光源11,12は互いに異なる波長の光ビームしB1, LB2を放射し、この光ビームしB1, LB2(拡散光)はカップリングレンズ13,14で平行光とされる。光ビームしB1はダイクロイックミラー15、ミラー16で反射され、プローブ20へ入射する。光ビームしB2はダイクロイックミラー15を透20過すると共にミラー16で反射され、プローブ20へ入射する。

【0013】プローブ20は、図2に示すように、高屈 折率物質21を被覆する遮光膜22に微小開口23を形 成したもので、入射した光ビームLB1、LB2を近接場 光として微小開口23から浸み出させる。

【0014】光検出器31,32は光記録媒体1の裏面側に配置されている。即ち、プローブ20から浸み出した近接場光は元の伝搬光に変換されて光記録媒体1を透過する。この透過光LB1'、LB2'はカップリングレ30ンズ33で集光され、透過光LB1'はダイクロイックミラー34を透過して光検出器31で検出される。透過光LB2'はダイクロイックミラー34で反射されて光検出器32で検出される。各光検出器31,32の検出信号は検出回路37に入力され、ここで読取り信号として取り出される。

【0015】一方、光記録媒体1は、図2に示すように、ガラス基板2上に、Auからなる薄膜3、Siからなる薄膜4及びSiNからなる保護膜5を設けたものである。各膜3,4,5の厚さは、それぞれ6nm、20 40nm、20nmである。この光記録媒体1はSi薄膜4の表面を前記プローブ20の微小開口23に対して近接場領域にまで近付けて近接場光を照射することで以下に説明する情報の記録/読取りを行う。

【0016】前記Au薄膜3とSi薄膜4は記録層として機能する。即ち、Siは光吸収材料であり、光を吸収することによって発生した熱でAuとSiとが相互拡散することで記録ビット6が形成される。AuとSiの2層薄膜にあっては、図3及び図4に示すように、薄膜を加熱していくと210℃付近において波長488nmの。50

光の透過率は急激に増加する(図3参照)。一方、波長、680nmの光の透過率は210℃付近において急激に 減少する。

【0017】従って、本光記録媒体1にあっては、AulーSi薄膜3.4を488nmと680nmの各波長の光に対して大きく異なる透過率を有する約210~3210℃の範囲の任意の温度に局部的に加熱して記録ビット。6を形成することで情報を記録する。勿論、前述の光読取り装置10を用いて光ビームを照射し、情報を記録することも可能である。

【0018】読取りには前記光読取り装置10を使用する。即ち、レーザ光源11からは波長488 nmの光ビームしB1を放射し、レーザ光源12からは波長680 nmの光ビームしB2を放射する。この光ビームしB1, LB2は、前述の如く、プローブ20の微小開口23から近接場光として浸み出し、Au-Si薄膜3,4の同一スポットを照射し、さらに元の伝搬光に変換されてガラス基板2を透過する。この透過光しB1、LB2、は前記光検出器31,32で検出される。

【0019】詳しくは、Au-Si薄膜3、4に形成された記録ピット6は、488nmの光ピームLBIに対しては透過率が高くなる(信号強度が強くなる)ように形成され、680nmの光ピームLBIに対しては透過率が低くなる(信号強度が弱くなる)ように形成されている。従って、検出回路37では、透過光LBI、LBI、の検出値の差分を記録ピット6の読取り信号とすることで、フォーカシングやトラッキングの誤差などで生じる検出信号の揺らぎに影響されることのないS/N比の良好な読取り信号を得ることができる。

【0020】また、本読取り装置10では微小開口23から近接場光を発生させるプローブ20を使用しているため、光ビームしB1、LB2の光軸を厳密に合わせる必要がなくなり、組立てや調整が容易になる。

【0021】なお、前記光記録媒体1において、記録用薄膜3,4はAu、Si以外に種々の材料を使用することができる。金属としては、Au以外にAl、Pt。Argなどを挙げることができる。光吸収材料としては、以Si以外にGe、Sbなどを挙げることができる。保護膜としては、光透過性及び耐熱性を有する種々の材料を使用することができる。

【0022】次に、近接場光発生素子を内蔵したタイプの光記録媒体40について説明する。図5に示すよう」に、光記録媒体40は、ガラス基板41上に、SiNからなる干渉膜42、Sbからなるウィンドウ膜43、SiNからなる中間膜44、Siからなる薄膜45、Au3からなる薄膜46及びSiNからなる保護膜47を設け、たちのである。各膜42~47の厚さは、それぞれ170のnm、15nm、20nm、15nm、20nm、62

【0023】前記光記録媒体40に対しては、対ラス書

板41側から対物レンズ49によって光ビームLBをウ ィンドウ膜43に集光させて情報を記録する。この光照 射によって、ウィンドウ膜43を構成するSbが光の吸 収で発熱して溶解し、微小な光透過部43 aが形成され る。なお、光透過部43 aは光照射時のみ形成され、『非 照射時には可逆的に透過率が低下する。そして、光透過 部43 aから近接場光が浸み出し、基Si-Au薄膜4等() 5,46が高温に加熱されて相互拡散することで記録ビ ット48か形成される、記録ビット48の熱ー光学特性 は前記記録ビット6と同様である。従って、波長が48 10 8nm及び680nmの光ビームをウィンドウ膜43に 集光させることで、記録ピット48を透過した光ビーム を前記光検出器31,32で検出すれば、その検出値の 差分をS/N比の良好な読取り信号として得ることがで

【0024】この読取りに際しては、図1に示したプロ ープ20は不要であり、これに代えて対物レンズを設け ればよい。

【0025】なお、ウィンドウ膜43としては、光照射 時のみ光透過部を形成する材料であれば、Sb以外の材 20 料を用いてもよい。

【0026】次に、第2実施形態としての光読取り装置 50を図6を参照して説明する。この読取り装置50 は、光記録媒体1'からの反射光を検出して予め記録さ れている情報を読み取るようにしたものである。即ち、 入射用の光学素子及びプローブは前記第1実施形態(図 1参照)と同様であり、同じ符号を付して示す。反射光 LB1 はハーフミラー16、ダイクロイックミラー3 4を透過し、カップリングレンズ35を介して光検出器 31へ入射するように構成されている。反射光LB2' はダイクロイックミラー34で反射し、カップリングレ ンズ36を介して光検出器32へ入射するように構成さ れている。 (1.5°) (0.5°)

【0027】光記録媒体1'は、図7に示すように、ガ ラス基板2上に、Siからなる薄膜4、Auからなる薄 膜3及びSiNからなる保護膜5を設けたものである。 各膜4, 3, 5の厚さは、それぞれ10 nm、20 n m、20nmである。Au-Si薄膜3,4は前述の如 く記録層として機能し、光を吸収することで発熱するS i とAuとが相互拡散することで記録ビット6'が形成 40 される.

【0028】この記録ピット6、を形成するAu-Si 薄膜3,4は、図8に示す反射率特性を有しており、波 長488nmの光に対しては230℃付近で反射率が急 激に減少し、波長632 nmの光に対しては230℃付 近で反射率が急激に増加する。従って、本光記録媒体な 632nmの各波長の光に対して大きく異なる反射率を 4.45 ··· Si薄膜 表示ない 有する約230℃以上の温度に局部的に加熱して記録ビジャル。48、記録ビジトル。20 1170 高温度

の光読取り装置50を用いて光ビームを照射し続情報を認 記録することも可能である。

【0029】読取りには前記光読取り装置50を使用する る. 即ち、レーザ光源11からは波長488 nmの光ビ ームLBIを放射し、レーザ光源12からは波長632點。 nmの光ビームLB2を放射する。この光ビームLB音響等 しBzはプローブ20の微小開口23から近接場光としず意 て浸み出し、Au-Si薄膜3,4の同一スポットを照 射し、さらに元の伝搬光に変換されて反射する。この反 射光LB1', LB2'がプローブ20等を介して前記光 検出器31,32で検出されることになる。 الناءد بالإندازان

【0030】記録ピット6、は波長の異なる光ビームし B1, LB2に対して反射率が大きく異なるように形成さご れているため、検出回路37で反射光しB1', LB2' の検出値の差分を読取り信号とする。これにて、フォー カシングやトラッキングの誤差などで生じる検出信号の 揺らぎに影響されることのないS/N比の良好な読取り 信号を得ることができる。

【0031】また、光記録媒体1'において、記録用薄 膜3,4はAu、Si以外の種々の材料を使用すること ができるのは、前記光記録媒体1と同様である。

【0032】なお、本発明に係る光読取り装置、光読取 り方法及び光記録媒体は前記実施形態に限定するもので はなく、その要旨の範囲内で種々に変更することができ、 る。例えば、近接場光発生素子としては前記プローブ2 0以外にも、固浸レンズ、ファイバプローブを用いるこ とができる。また、入射用光学系や、読取り用の光検出 光学系及び検出回路の構成は任意である。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】第1実施形態としての光読取り装置を示す概略 構成図。

【図2】図1に示されているプローブと光記録媒体の断 面図.

【図3】記録用薄膜の熱-光学特性 (波長:488 n m)を示すグラフ.

【図4】記録用薄膜の熱-光学特性 (波長:680 n m)を示すグラフ。

【図5】いま一つの光記録媒体の断面図。

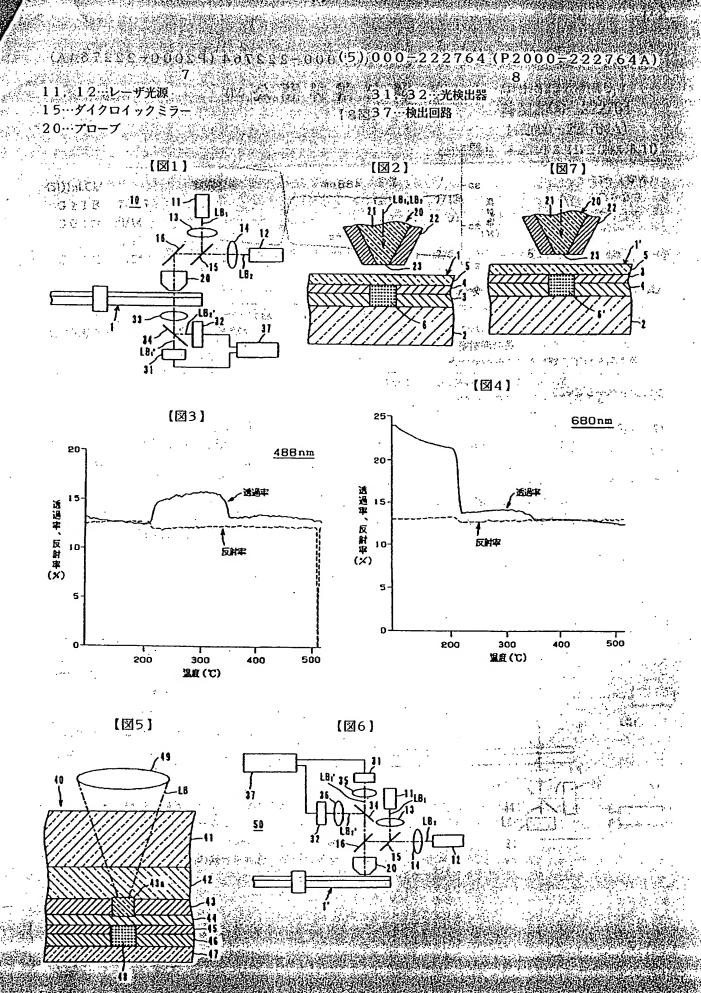
【図6】第2実施形態としての光読取り装置を示す概略 構成図.

【図7】図6に示されているプローブと光記録媒体の断 面図、

【図8】記録用薄膜の熱一光学特性 (波長:488 ㎡) m、632nm)を示すグラフ。 【符号の説明】

1, 1 ... 40…光記録媒体 2...

ット6つを形成することで情報を記録する。勿論、前述150、10、950、光読取り装置では学典ない。



7.10 + 5.00 0 2 3) + 3.7 5.5 5 - 0.0 0 (6) 0.0 0 - 2.2 2.7 64 (P2000 - 2.2 2.7 64A)

### フロントページの続き

(72)発明者 富永 淳二

茨城県つくば市東一丁目1番地4 工業技 術院産業技術融合領域研究所内

(72)発明者 阿刀田 伸史

大學(4)各種聯合體質大意自由於出述事,一一一一

茨城県つくば市東一丁目1番地4 工業技 術院産業技術融合領域研究所内、

差别斯の弗學等/数500mm-196至分析: 7度6% 1000克

手表的编码。1200年12日日本大学中国大学工艺的特别工艺的数字的。

(72) 発明者 佐藤 彰

大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪国際ビル ミノルタ株式会社内 Fターム(参考) 5D029 JB03 JB05 JB17 JB47 JC02 JC03 JC04 KA24 5D119 AA11 AA22 BA01 DA01 DA05

EB12 EC14 EC47 JA35